

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국



(10) 국제공개번호
WO 2023/211027 A1

2023년 11월 2일 (02.11.2023)

(51) 국제특허분류:

C23C 16/34 (2006.01) C23C 16/455 (2006.01)
C23C 16/36 (2006.01) C23C 16/32 (2006.01)
C23C 16/40 (2006.01) C07F 7/10 (2006.01)
C23C 16/30 (2006.01)

(21) 국제출원번호:

PCT/KR2023/005085

(22) 국제출원일:

2023년 4월 14일 (14.04.2023)

(25) 출원언어:

한국어

(26) 공개언어:

한국어

(30) 우선권정보:

10-2022-0050831 2022년 4월 25일 (25.04.2022) KR

(71) 출원인: 엠케미칼 주식회사 (M CHEMICALS INC.)
[KR/KR]; 27721 충청북도 음성군 원남면 원남산단로
261, Chungcheongbuk-do (KR).

(72) 발명자: 양병일 (YANG, Byeong-il); 34402 대전광역시
대덕구 계족산로 135, Daejeon (KR). 정희연 (JEONG,
Hee-Yeon); 27172 충청북도 제천시 남산로 88,

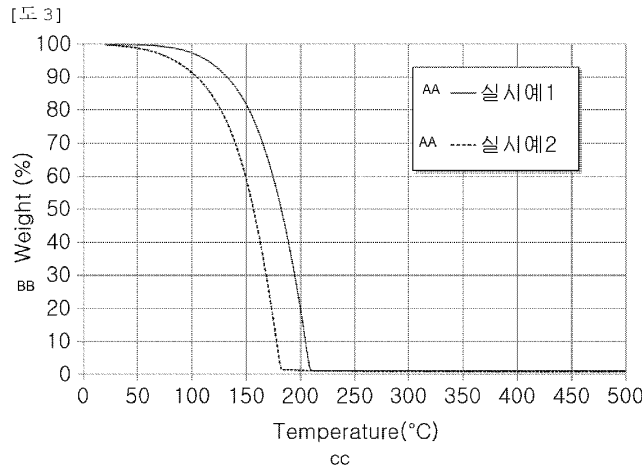
Chungcheongbuk-do (KR). 성영주 (SEONG, Yeong-
Ju); 34046 대전광역시 유성구 유성대로1689번길 26-8,
Daejeon (KR). 천성학 (CHEON, Seong-Hak); 27938
충청북도 증평군 증평읍 조중4길 72, Chungcheong-
buk-do (KR). 김주용 (KIM, Joo-Yong); 14985 경기도
시흥시 배미곶길 23, Gyeonggi-do (KR). 변영훈 (BYUN,
Young-Hun); 27945 충청북도 증평군 증평읍 삼일로6길
4, Chungcheongbuk-do (KR).

(74) 대리인: 제일특허법인(유) (FIRSTLAW P.C.); 06775
서울특별시 서초구 마방로 60, Seoul (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의
국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD,
MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO,
NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,

(54) Title: SILICON PRECURSOR COMPOUND AND PREPARATION METHOD THEREFOR, AND SILICON-CONTAINING
THIN FILM PREPARATION METHOD USING SILICON PRECURSOR

(54) 발명의 명칭: 실리콘 전구체 화합물 및 이의 제조방법, 실리콘 전구체 이용한 실리콘 함유 박막의 제조방법



(57) Abstract: The present invention relates to a novel silicon precursor compound enabling a silicon-containing thin film having excellent quality to be prepared, and a preparation method therefor, and a silicon-containing thin film preparation method using the silicon precursor compound.

(57) 요약서: 본 발명은 우수한 품질의 실리콘 함유 박막을 제조 가능한 신규 실리콘 전구체 화합물 및 이의 제조방법, 실리콘 전구체 화합물을 이용한 실리콘 함유 박막 제조방법에 관한 것이다.

[다음 쪽 계속]

WO 2023/211027 A1

SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의
역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM,
KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ,
UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM,
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

- 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))
- 청구범위 보정 기한 만료 전의 공개이며, 보정서를
접수하는 경우 그에 관하여 별도 공개함 (규칙 48.2(h))